Поз. обозначе					Наименование	Кол.	Примеч.		
					<u>Диоды</u>				
VD2, VD3, VD5	VD4,	1N4007	7 (Diotec S	Semicon	ductor, Германия)	4			
					<u>Конденсаторы</u>				
C1, C1	.2		енсатор con, США		пролитический К50-35, 220мкФ 100В	2			
C2, C1	С2, С13 Конденсатор плёночный CL21, 1мкФ 63В (Китай)				2				
C3					1				
C4		Конде Герма	-	элекп	пролитический 22омкФ, 50B (EPCOS,	1			
C5		Конденсатор керамический К10-17Б имп., 47онФ, 50В (Китай)							
C6, C1	.1	Конденсатор электролитический К50-6, 10мкФ, 25В (Jamicon, США)							
C <sub>7</sub>		Конденсатор керамический К10-17Б имп., 220пФ, 50В (Китай)				1			
C8			енсатор b, 100B (I		1				
С9		Конде (Кита	енсатор ай)	керал	1				
C10			енсатор con, США		1				
Moss Disease	AIO 3	040.445	п.э	П	ИУ4.11.03.03.23.05.52.0	9.00	о1 ПЭ3		
Изм Лист №д Разраб. Доруни		,	Подп.	Дата		Лu	т. Лист Листов		
	Семенцов				Усилитель		1 2		
Н. контр.					низкой частоты		МГТУ им Н.Э. Баумана		

Утв.		Перечень элементов	Кафедра ИУ4
			Группа ИУ4 – 52Б

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	<u>Разъёмы</u>		
XS1	Клеммник разъёмный 15EDGRC-3.81-03P (Degson, Kumaŭ)	1	
XS2	Клеммник разъёмный 15EDGRC-3.81-02P (Degson, Kumaŭ)	1	
XS <sub>3</sub>	Гнездо стерео 3,5мм ST-025 (Dragon City Industries, Kumaŭ)	1	
	<u>Резисторы</u>		
R1	CF-100 1Bm 2,2кОм 5%	1	
R2, R3	CF-100 1Bm 1кОм 5%	2	
R4, R6	SQP 5Bm 0.22Oм 5%	2	
R5	CF-25 0,25Bm 2.7кОм 5%	1	
R <sub>7</sub>	CF-25 0,25Bm 8.2кОм 5%	1	
R8	CF-25 0.25Вт 22кОм 5%	1	
R9	MO-200 2Bm 1Ом 5%	1	
R10	SQP 10Bm 0.33Ом 5%	1	
R11	CF-25 0,25Bm 100Ом 5%	1	
R12	CF-25 0,25Bm 750Ом 5%	1	
R13	CF-25 0,25Bm 3Ом 5%	1	
	<u>Транзисторы</u>		
/T1	TIP142 (STMicroelectronics, Франция)	1	
/T2, VT3	BC556B (Diotec Semiconductor, Германия)	2	
/ <sub>T4</sub>	TIP147 (STMicroelectronics, Франция)	1	
/T <sub>5</sub>	BD241C (STMicroelectronics, Франция)	1	
Лзм Лист № д	ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.	.001	ПЭ 3